

# 2SD467

シリコン NPN エピタキシャル形

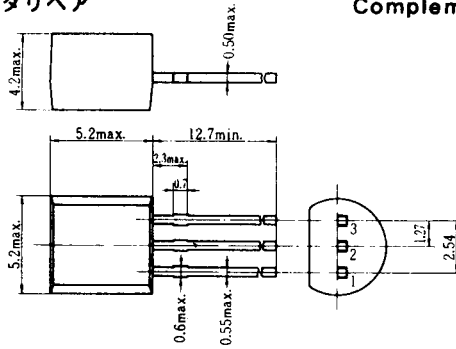
低周波電力増幅用

2SB561とコンプリメンタリペア

SILICON NPN EPITAXIAL

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER

Complementary pair with 2SB561



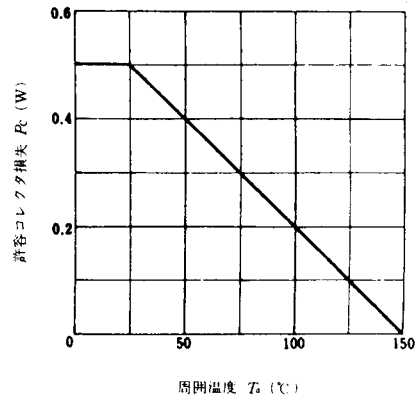
(JEDEC TO-92)

1. エミッタ: Emitter
  2. コレクタ: Collector
  3. ベース: Base
- (Dimensions in mm)

## 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	2SD467	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	25	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	20	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	5	V
コレクタ電流	$I_C$	0.7	A
せん頭コレクタ電流	$I_{C(sat)}$	1.0	A
許容コレクタ損失	$P_C$	0.5	W
機合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150	$^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	25	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$	20	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$	—	—	1.0	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE}^*$	$V_{CE}=1\text{V}, I_C=0.15\text{A}$ (Pulse Test)	85	—	240	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=0.5\text{A}, I_B=0.05\text{A}$	—	0.19	0.5	V
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=1\text{V}, I_C=0.15\text{A}$ (Pulse Test)	—	0.76	1.0	V
取得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE}=1\text{V}, I_C=0.15\text{A}$ (Pulse Test)	—	280	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	12	—	pF

\* $h_{FE}$ は $h_{FE}$ の値により下記のように2区分し、現品に表示してあります。

\* $h_{FE}$  2SD467 is grouped by  $h_{FE}$  as follows.

B	C
85~170	120~240